

КРЕМНИЕВЫЙ ТРАНЗИСТОР
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ
п-р-п

П501

По состоянию на август 1963 г.

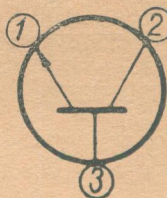
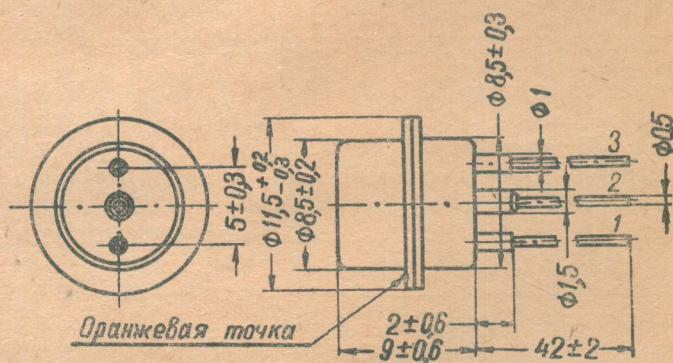
По техническим условиям ЖКЗ.365.044 ТУ.

Основное назначение — усиление и генерирование электрических колебаний высокой частоты.

Оформление — в металлическом герметичном корпусе.

ОБЩИЕ ДАННЫЕ

Высота наибольшая (без выводов)	9,6 мм
Диаметр наибольший	11,7 мм
Вес наибольший	1,5 г



- 1 — эмиттер
- 2 — коллектор
- 3 — база

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ #

Обратный ток коллектора:	
при температуре 20° С *	не более 50 мка
» » 120° С	не более 100 мка
Коэффициент усиления по току β :	
на частоте 20 Мгц	не менее 0,7
» » не более 1000 гц	не менее 9
Частота генерации	не менее 10 Мгц
Выходная проводимость Δ	не более 3 мксим
Емкость коллектора $\square$	не более 10 пф
Долговечность	5000 ч

При напряжении коллектора 10 в и токе эмиттера 3 ма.

* При напряжении коллектора 20 в.

○ В схеме с общим эмиттером.

△ На частоте не более 1000 гц.

□ На частоте 5 Мгц.

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Наибольшее напряжение:	
коллектор—база	20 в
коллектор—эмиттер *	20 в
Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база	1 в
Наибольший ток:	
эмиттера	10 ма
базы	10 ма
Наибольшая рассеиваемая мощность при температу- ре корпуса до 60° С Δ	150 мвт
Наибольшая температура коллекторного перехода	плюс 150° С

* При короткозамкнутых выводах эмиттера и базы.

Δ При температуре корпуса (t_K° С) от 60 до 125° С наибольшую рассеиваемую мощность рассчитывают по формуле

$$P_{\text{макс}} = \frac{150 - t_K^\circ}{0,6} \text{ (мвт)}.$$

УСТОЙЧИВОСТЬ ПРОТИВ ВНЕШНИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ

Многоцикличное изменение температуры окружа- ющей среды	от минус 60 до плюс 120° С
Температура окружающей среды:	
наибольшая	плюс 120° С
наименьшая	минус 60° С

**КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
n-p-n**

П501	П502А
П501А	П502Б
П502	

Наибольшая относительная влажность при температуре $40 \pm 5^\circ \text{C}$	98%
Давление окружающей среды:	
наибольшее	2 ати
наименьшее	5 мм рт. ст.
Наибольшее ускорение:	
при испытании на вибропрочность *	15 g
линейное	150 g
при многократных ударах Δ	150 g

* На частоте 50 гц.
 Δ 4000 ударов с частотой 20—80 ударов в минуту.

П501А

Коэффициент усиления по току на частоте не более 1000 гц	не менее 19
--	-------------

Примечание. Остальные данные такие же, как у П501.

П502

Частота генерации	не менее 30 Мгц
Коэффициент усиления по току на частоте 20 Мгц	не менее 1
Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база	3 в

Примечание. Остальные данные такие же, как у П501.

П502А

Частота генерации	не менее 30 Мгц
Коэффициент усиления по току:	
на частоте 20 Мгц	не менее 1
» » не более 1000 гц	не менее 19
Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база	3 в

Примечание. Остальные данные такие же, как у П501.

П502Б

Обратный ток коллектора при температуре 20°C *	не более 50 мка
Частота генерации	не менее 30 Мгц
Коэффициент усиления по току на частоте 20 Мгц	не менее 1

П502Б П503
П502В П503А

КРЕМНИЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ
ВЫСОКОЧАСТОТНЫЕ
п-р-п

Наибольшее напряжение:

коллектор—база 30 в

коллектор—эмиттер 30 в

Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база 3 в

* При напряжении коллектора 30 в.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П501.

П502В

Обратный ток коллектора при температуре 20° С * не более 50 мка

Частота генерации не менее 30 Мгц

Коэффициент усиления по току:

на частоте 20 Мгц не менее 1

» » не более 1000 гц не менее 19

Наибольшее напряжение:

коллектор—база 30 в

коллектор—эмиттер 30 в

Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база 3 в

* При напряжении коллектора 30 в.

Примечание. Остальные данные такие же, как у П501.

П503

Частота генерации не менее 60 Мгц

Коэффициент усиления по току на частоте 20 Мгц не менее 1,5

Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база 3 в

Примечание. Остальные данные такие же, как у П501.

П503А

Частота генерации не менее 60 Мгц

Коэффициент усиления по току:

на частоте 20 Мгц не менее 1,5

» » не более 1000 гц не менее 13

Наибольшее обратное напряжение эмиттер—база 3 в

Примечание. Остальные данные такие же, как у П501.